

Диоды Ганна

Студента IV курса:
Аникеева Ильи

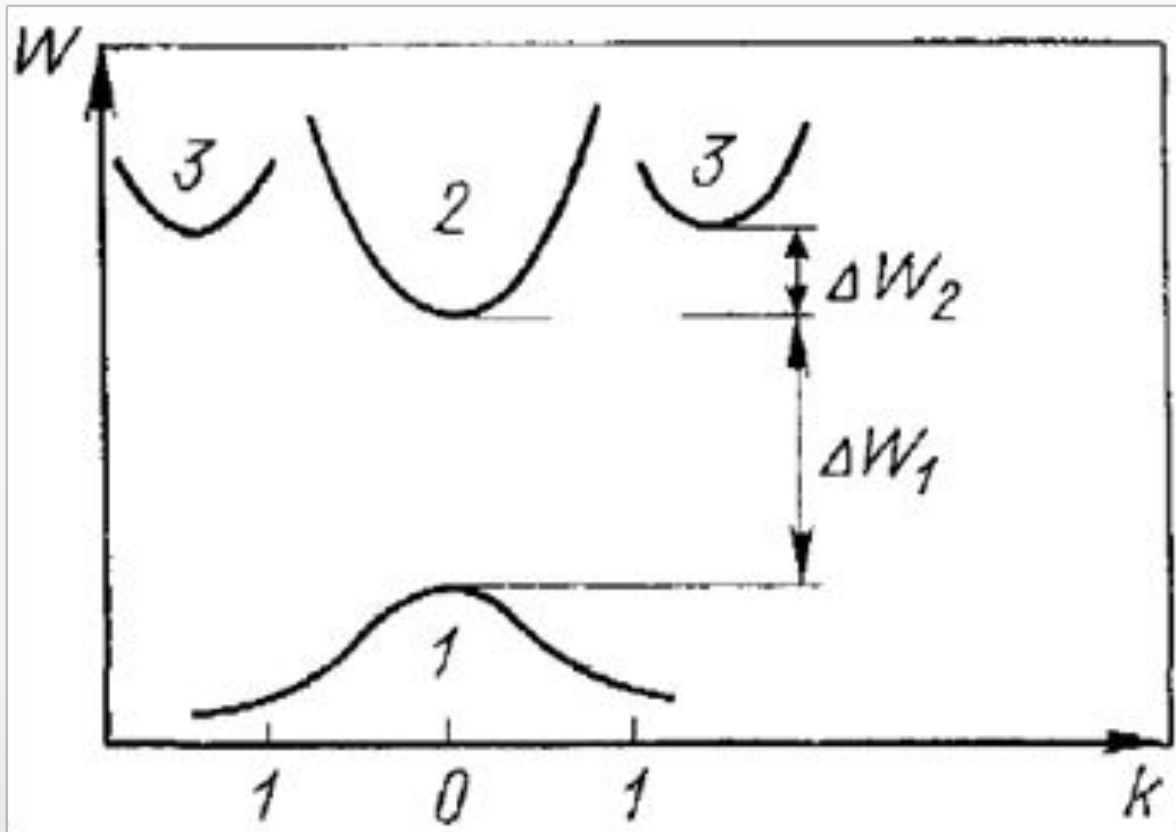


Рис. 1 Зависимость энергии электронов в валентной зоне 1 и зоне проводимости 2, 3 арсенида галлия от волнового числа k .

$$\Delta W_1 = 1,43 \text{ эВ}$$

$$\Delta W_2 = 0,36 \text{ В}$$

Плотность тока через образец в условиях малых напряжённостей электрических полей E можно выразить следующим соотношением:

$$j = en_1\mu_1 E$$

где n_1 – концентрация электронов в нижней долине. Плотность тока через образец, начиная с некоторого критического значения электрического поля E_t :

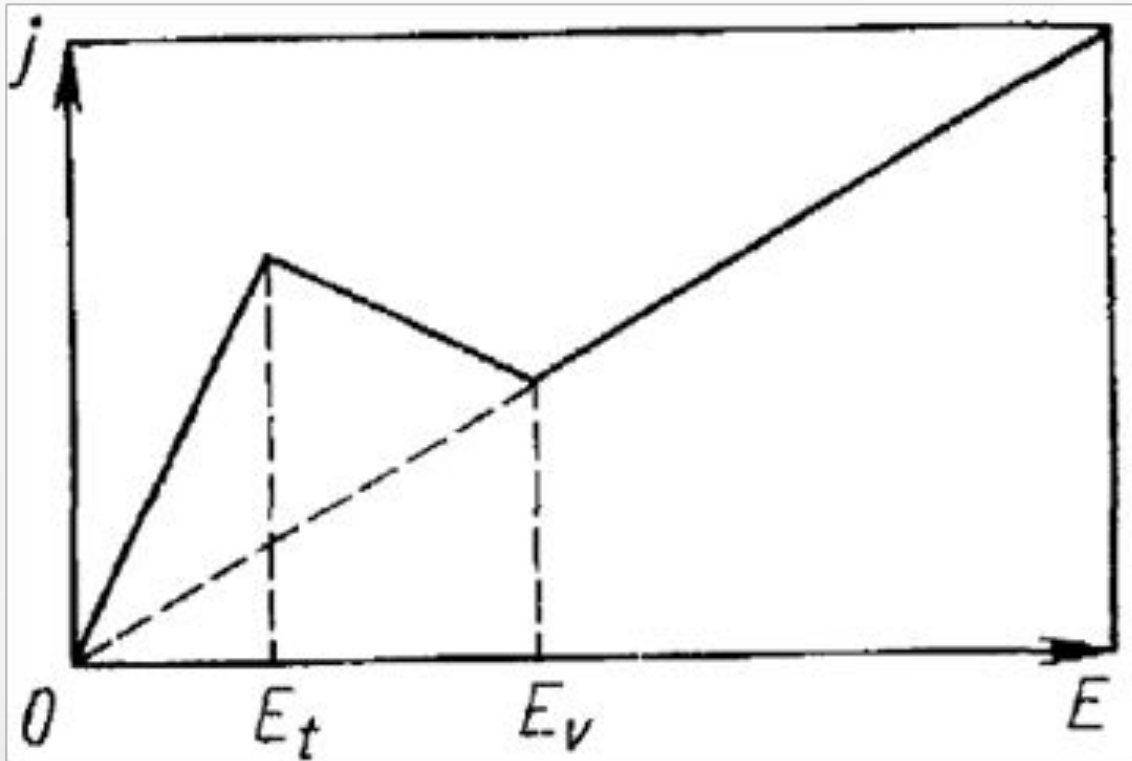
$$j = e \frac{n_1\mu_1 + n_2\mu_2}{n_1 + n_2} E$$

Здесь n_2 – концентрация электронов в верхней долине, зависящая от напряжённости поля E

При очень больших полях $E > E_v$ все электронные перейдут в верхнюю долину и плотность тока через образец:

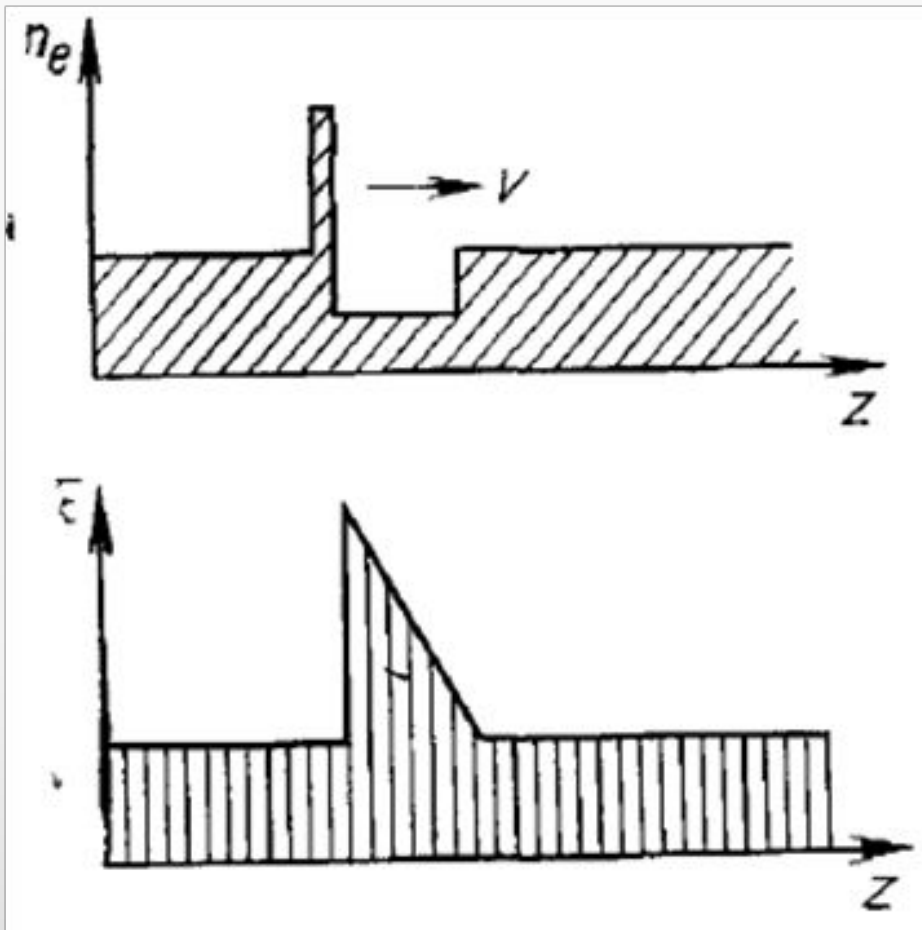
$$j = en_2\mu_2 E$$

где $n_2 = n_1$ – концентрация электронов в зоне проводимости.



Наличие падающего участка на ВАХ объясняет возникновение эффекта Ганна. При этом следует иметь в виду, что форма ВАХ, полученная выше, соответствует равномерному распределению напряжённости поля вдоль образца, а в реальном случае поле резко неоднородно.

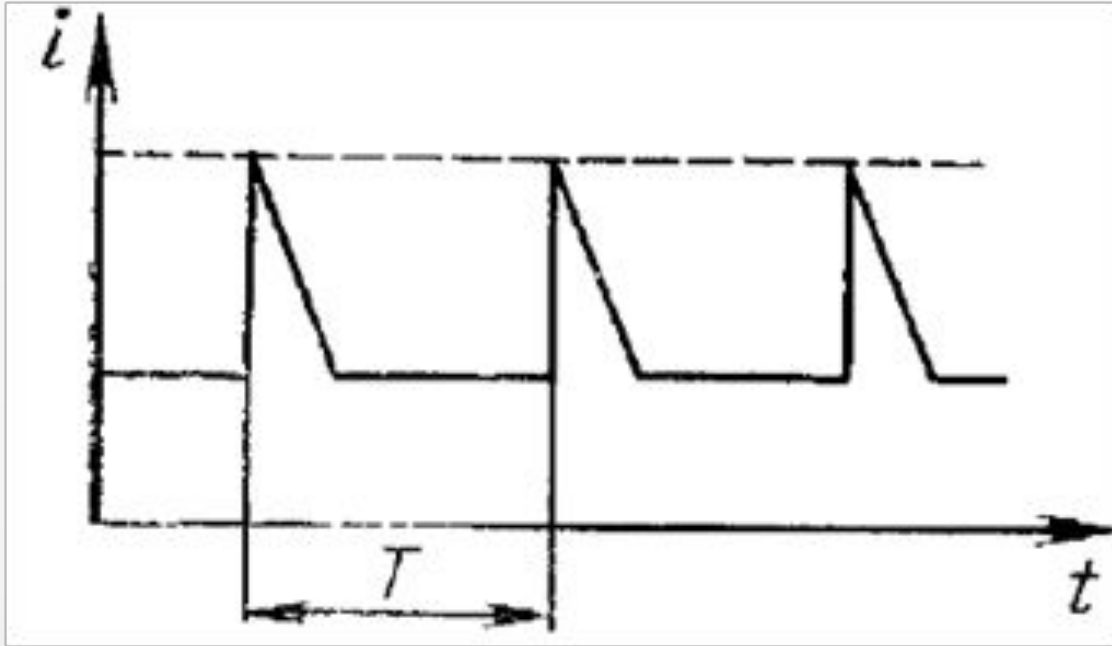
Рис. 2. ВАХ прибора.



Область высоких значений напряжённости электрического поля называется **доменом сильного поля**.

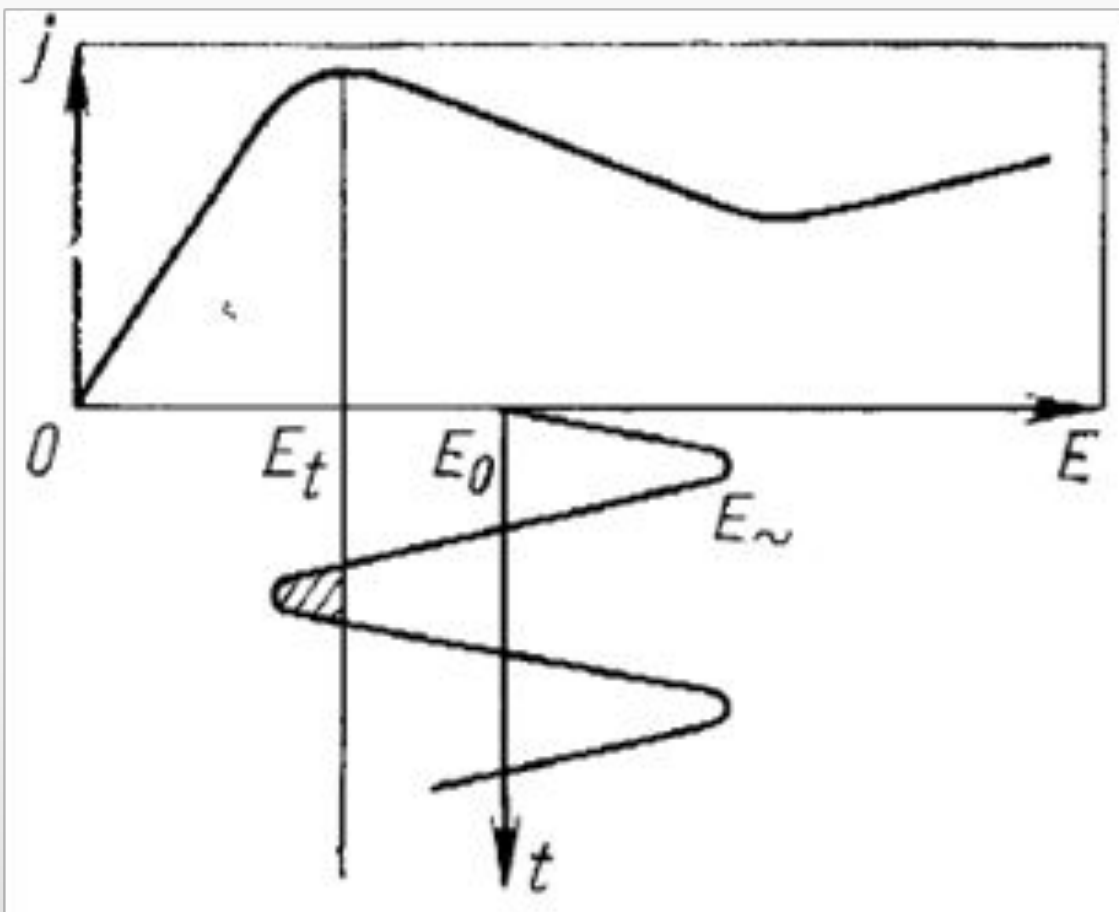
Обычно в образце возникает лишь один домен, поскольку напряжённость поля вне его падает ниже критической. Домен в диодах Ганна образуется непосредственно у катодного электрода, и пройдя через образец со скоростью порядка $10^7 \text{ см} \cdot \text{с}^{-1}$, исчезает у анода. После этого у катода формируется новый домен и цикл повторяется.

Рис. 3 Установившиеся распределения зарядов и напряжённости поля вдоль кристалла по оси z .



Период ганновских осцилляций составляет $T=l/v$. По техническим причинам длину образца l не удаётся сделать меньшей нескольких микрон. Кроме того, при $l > 2,5$ мм, вследствие хаотически меняющихся мест зарождения доменов, осцилляции приобретают шумовой характер. Эти обстоятельства определяют диапазон частот осцилляций: $2 \cdot 10^7 - 10^{10}$ Гц.

Рис. 4 Ток во внешней цепи прибора.

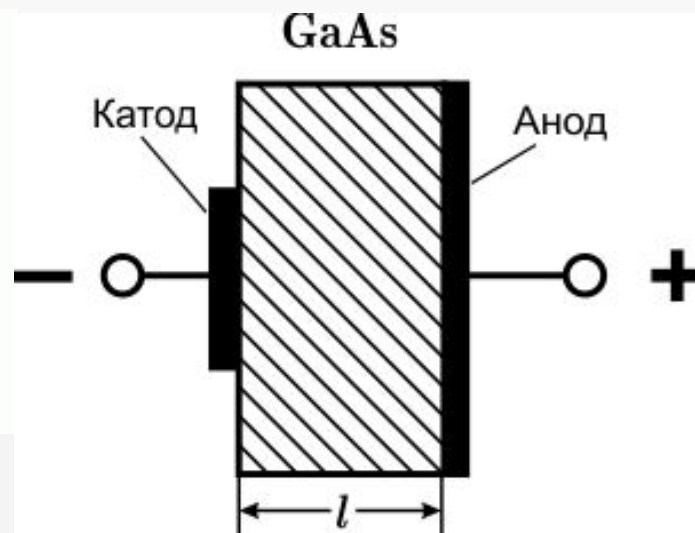


Дальнейшая разработка теоретических и экспериментальных проблем, связанных с эффектом Ганна, привела к открытию нового типа колебаний при напряжённостях, значительно превышающих пороговое значение ганновских осцилляций. Частота колебаний в этом режиме может быть выше пролётной, а её зависимость от длины образца l прямо пропорциональная: с увеличением длины диода частота колебаний увеличивается. Этот режим назван **режимом ограниченного накопления объёмного заряда (ОНОЗ)**.

Рис. 5 ВАХ диода по действию поля смещения, превышающее пороговое значение, и переменного СВЧ-поля, возникающего при возбуждении резонатора.

Диапазон частот, ГГц	Выходная мощность, Вт		КПД, %	Примечание
	непрерывный	импульсный		
1—2	—	250	4—6	Доменный режим осцил- ляций
4—8	1	35	4—6	То же
40	0,075	—	—	»
1—2	—	6000	25	Режим ОНОЗ
4—8	—	2000	10—12	»
12—18	—	200	10	»

Табл. 1 Параметры приборов СВЧ-диапазона, в которых используются диоды Ганна на основе GaAs.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !